

2SA892

■シリコンPNPエピタキシャルプレーナ形トランジスタ

☆ダーリントントランジスタ

☆レジンモールドケース

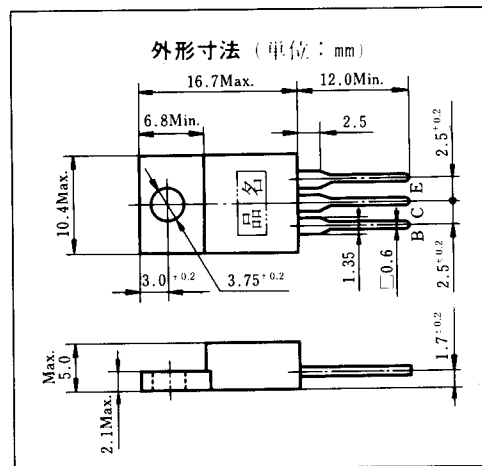
○一般用

○通信産業用

■最大定格 (Ta=25°C)

項 目	記 号	2SA892
コレクタ・ベース電圧	V _{CB0}	-40V
コレクタ・エミッタ電圧	V _{CEO}	-40V
エミッタ・ベース電圧	V _{EB0}	-6V
コレクタ電流	I _C	-6A (※Pulse-10A)
ベース電流	I _B	-0.5A
許容コレクタ損失	P _C	40W (フランジ温度25°C)
接合部温度	T _j	150°C
保存温度	T _{stg}	-55 ~ +150°C

※Pulse:10mSec.以下, Duty cycle 50%以下



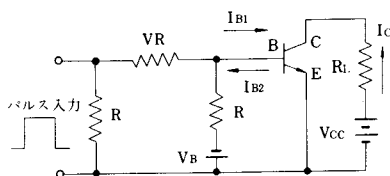
■電気的特性 (Ta=25°C)

項 目	記 号	試 験 条 件	2SA892
最大コレクタシャ断電流	I _{CB0}	V _{CB} = -40V	-100μA
最大エミッタシャ断電流	I _{EB0}	V _{EB} = -6V	-20mA
コレクタ・エミッタ電圧	V _{CEO}	I _C = -5mA	-40V
直流電流増幅率	h _{FE}	V _{CE} = -4V I _C = -5A	300Min.
コレクタ飽和電圧	V _{CE(sat)}	I _C = -5A I _B = -50mA	-1.5V Max.
シャ断周波数	f _T	V _{CE} = -12V I _E = 0.1A	15MHz Typ.

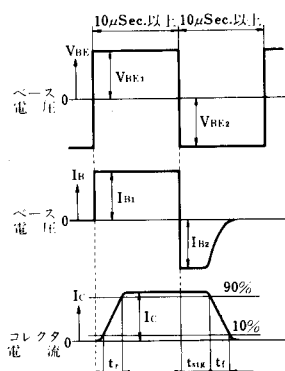
■代表的スイッチング特性 (エミッタ接地)

V _{CC} (V)	R _L (Ω)	I _C (A)	I _{B1} (mA)	I _{B2} (mA)	t _r (μSec.)	t _{stg} (μSec.)	t _f (μSec.)
-20	4	-5	-20	20	0.7	1.2	0.7

スイッチング特性測定回路



測定条件



周囲温度と最大許容損失

